纳米 ZnO 和 ZnO-SiO₂ 复合薄膜的光学性质研究*

袁宁一 何泽军 赵常宁 李 峰 周 懿 李金华

(江苏工业学院数理学院,常州 213164)(2007年7月16日收到2007年11月9日收到修改稿)

通过溶胶凝胶(sol-gel)法分别在玻璃衬底上制备了 ZnO 纳米薄膜和 ZnO-SiO₂ 纳米复合薄膜,并利用紫外-可见 光分光光度计对薄膜的光学性能进行了分析.可见光-紫外透射谱显示,随着 ZnO 溶胶浓度从 0.7 mol/L 降低到 0.006 mol/L ,制备的 ZnO 薄膜从只出现一个 380 mf(对应的光学禁带宽度为 3.27 eV)左右的吸收边到在 380 和 320 nn(对应的光学禁带宽度为 3.76 eV)左右各出现一个吸收边,并且随着 ZnO 溶胶浓度的降低,在 380—320 nm 波段 内的透过率明显提高.而 ZnO-SiO₂ 复合薄膜只在 310 nm 左右出现一个吸收边.SiO₂ 的包覆宽化了 ZnO 的禁带宽度, 包覆后的禁带宽度可达到 3.87 eV.

关键词:纳米 ZnO, ZnO-SiO₂复合薄膜,溶胶凝胶法,透射率 PACC:7840,7360F

1.引 言

ZnO 作为一种直接带隙的宽禁带半导体材料, 在室温下其禁带宽度为 3.37 eV 并且激子束缚能高 达 60 meV 因此可以实现室温下的激子发射,产生 近紫外的短波发光,它在制备短波光电器件(如紫外 探测器、紫外激光器等)方面具有特殊的优越 性^{1-3]}.ZnO 纳米粒子还具有体材料所不具备的表 面效应、量子尺寸效应和隧穿效应 从而产生了许多 优异的光、电、磁等方面的性质 在太阳电池、图像处 理、传感器、催化剂、表面声波、透明电极等方面具有 广泛的应用.纳米 ZnO 随着粒度的减少,它的表面 效应和量子尺寸效应越来越明显.因此,对它光学性 能方面的研究也越来越受到了人们的重视,近年来, 在 SiO, 基体中制备 ZnO 纳米颗粒的研究表明 相比 于 ZnO 体材料 ,ZnO-SiO,不仅具有更强的紫外发光 能力 而且还具有优异的非线性光学特性、饱和吸收 率和光学双稳特性^[4-10].本文采用溶胶凝胶(sol-gel) 法在玻璃衬底上制备了纳米 ZnO 和 ZnO-SiO2 薄膜. 对薄膜的光学性质进行了研究,并分析了溶胶凝胶 法的制备条件对薄膜光学性质的影响.

2. 样品制备

采用溶胶凝胶法在玻璃衬底上生长 ZnO 和 ZnO-SiO₂ 纳米复合薄膜.

2.1. 配 胶

取 4.5 ml 正硅酸乙酯(TEOS)溶液按 1:10 的比 例用无水乙醇稀释至 50 ml.陈化 5—8 d 后,形成无 色透明的 SiO₂ 溶胶 A 郑 0.2771 g(1.25×10⁻³ mol) 分析纯的醋酸锌(Zn(Ac)·2H₂O)粉末和 0.0521 g (1.25×10⁻³ mol)氢氧化钠(NaOH)块体溶于 50 ml 的无水乙醇中,用玻璃棒搅拌 30 min,形成 ZnO 乙醇 溶液.刚配好的溶液有些浑浊,过滤后陈化 3 d,形成 略显乳白色的 ZnO 溶胶 B.

取溶胶 B,用无水乙醇稀释成浓度分别是 0.006 0.02 0.4 和 0.7 mol/L的 ZnO 溶胶.溶胶不完 全透明 略呈乳白色.

取 5 ml 溶胶 A 和 15 ml 溶胶 B 混合成无色透明的 ZnO-SiO₂ 溶胶 其中 ZnO 摩尔浓度为 0.02 mol/L, ZnO 与 SiO₂ 的摩尔比为 1:5.

2.2.涂 胶

采用清洗液(其中 NH₃, H₂O₂和 H₂O 的摩尔比

^{*} 江苏省自然科学基金(批准号:BK2006042)资助的课题.

为1:1:3)对所用衬底载玻片的表面进行清洗和亲 水处理,然后涂胶.匀胶转速为550r/min,时间为9 s;甩胶转速为6000r/min,时间为30s.

2.3. 退火处理

利用快速退火炉在空气气氛中对薄膜进行退火 处理.第一种退火条件是在 150 ℃下退火 5 min,然 后在 350 ℃下退火 10 min;第二种退火条件是在 150 ℃下退火 5 min,然后在 350 ℃下退火 10 min,最后 在 600 ℃下再退火 10 min.在衬底上每涂一层溶胶 后即进行一次退火处理,如此反复涂 4 层.

3. ZnO 纳米微粒和 SiO₂ 的生长机理

3.1.ZnO 纳米微粒的生长机理

ZnO 纳米微粒的制备大致可分为反应前体的 制备、前体水解、颗粒陈化生长及颗粒纯化四个 步骤.醋酸锌在醇介质中首先预水解生成前体 Zn₁₀O₄(Ac)₂¹¹¹,加入 NaOH 后,前体发生进一步的 水解反应,生成 ZnO 颗粒.反应过程如下:

 $10Zn(Ac) + 4H_2O \rightarrow Zn_{10}O_4(Ac) + 8HAc$, (1) $Zn_{10}O_4(Ac) + 12OH^- \rightarrow 10ZnO + 12Ac^- + 6H_2O(2)$

NaOH + HAc →NaAc + H₂O. (3) 这一试验条件可生成稳定的 ZnO 溶胶.但在该条件 下还有另一副反应发生,生成碱式乙酸锌,即

 $Zn_{10}O_4$ (Ac)₂ + 6H₂O → 10Zn(OH)Ac + 2HAc.(4) 碱式乙酸锌的生成有可能会影响 ZnO-SiO₂ 纳米复 合薄膜的性能.为了尽量减少碱式乙酸锌的影响,溶 胶通过 1—3 d 的陈化,使碱式乙酸锌继续分解成为 ZnO^[12].

3.2.SiO₂的生长机理

SiO₂ 主要是通过 TEOS 溶液的水解反应和硅酸 缩聚反应而成.TEOS 溶液的水解反应过程为

S(OC₂H₅) + 4H₂O → S(OH) + 4C₂H₅OH.(5) 硅酸缩聚反应过程为

$$\equiv Si - OH + HO - Si \equiv \rightarrow \equiv Si - O - Si \equiv + H_2O.$$
(6)

3.3.ZnO-SiO₂ 溶胶形成

因为 ZnO 不溶于乙醇和水,所以配制的 ZnO 乙醇溶液会略显乳白色.当 SiO₂ 乙醇溶液和 ZnO 乙醇

溶液按一定比例混合时,ZnO 乙醇溶液中的 NaOH 会进一步催化 TEOS 的水解,且 SiO₂ 会以配键的形 式与 ZnO 结合,使它溶解在乙醇溶液中,所以配制 的 ZnO-SiO₂ 复合溶胶为无色透明溶胶.

4. ZnO 薄膜的透射率

利用日本岛津公司生产的 Shimadzu UV-2450 型 紫外-可见光分光光度计对制备的样品进行透射率 测试.测试前,先用两片清洗过的载玻片对仪器进行 校准.

4.1.ZnO 溶胶浓度对 ZnO 薄膜透射率的影响

利用浓度为 0.7 .0.4 .0.02 和 0.006 mol/L 的溶 胶制备得到四个 ZnO 薄膜样品,分别称为样品A、样 品 B、样品 C 和样品 D.图 1 是这四个样品经 600 ℃ 退火处理后的可见-紫外光透射光谱,由图1可以看 出 四个样品在 380 nm 以上波段的透射率达到了 90%以上,从图 1 还可看出:样品 A 在 380 nm 左右 透射率开始快速下降,出现了一个明显的吸收边,样 品 B 在 380 nm 左右出现了第一个吸收边 透射率降 到了 45% 左右后 在 320 nm 左右又出现了一个明显 的吸收边,透射率在275 nm 左右几乎降为零.样品 C在380 nm 处透射率开始下降,降到65% 左右,在 320 nm 处再次出现明显下降 ,在 275 nm 左右透射率 也几乎降为零,样品 D 虽然在 380 nm 处透射率也有 一个下降,但仅仅从92%左右下降到88%左右,随 后在 320 nm 出现一个明显的吸收边,由以上分析可 知 随着溶胶浓度的降低 在 ZnO 薄膜可见-紫外光 透射光谱中出现了新的吸收边,并且在 320-380 nm



图 1 不同溶胶浓度制备的 ZnO 薄膜的可见-紫外光透射光谱

区间的透射率随着溶胶浓度的降低而明显提高.

4.2. 不同退火温度对 ZnO 薄膜透射率的影响

图 2 是利用浓度为 0.02 mol/L 的 ZnO 溶胶制备 的 ZnO 薄膜样品(结晶温度分别是 350 和 600 ℃)的 可见-紫外光透射光谱.从图 2 可以看出,经过两个 不同温度退火的样品,薄膜的吸收边位置变化不明 显.从图 2 还可以看出,随着退火温度的提高,薄膜 在 600 nm 波长以下的波段范围内透射率有明显的 提高.

4.3.SiO2 包覆对 ZnO 薄膜透射率的影响

图 3 是利用 ZnO 浓度为 0.02 mol/L ZnO 与 SiO₂ 的摩尔比为 1:5 的溶胶制备的 ZnO-SiO₂ 复合薄膜和 利用 ZnO 浓度为 0.02 mol/L 制备的纯 ZnO 薄膜的可 见-紫外光透射光谱.在同一退火温度条件下,对比 用 SiO₂ 包覆的 ZnO 薄膜和纯 ZnO 薄膜的透射谱可 以看出 没用 SiO₂ 包覆的纯 ZnO 薄膜有两个吸收边 (分别在 380 320 nm 左右);而用 SiO₂ 包覆的 ZnO 复 合薄膜只有一个吸收边(在 310 nm 左右),没有出现 体材料在 380nm 左右的特征吸收边.



图 2 350 和 600 ℃下退火得到的 ZnO 薄膜的可见-紫外光 透射光谱

5. 结果分析与讨论

ZnO 纳米粒子的透射光谱在吸收边附近有较长拖尾,这种拖尾是由于缺陷态、粒子尺寸不均匀或者 是间接跃迁造成的.拖尾的存在使得对吸收边和光 学禁带宽度的精确确定造成困难.目前一般采用的



图 3 ZnO和 ZnO-SiO₂ 薄膜的可见-紫外光透射光谱

方法是^[13,14]根据薄膜的透射谱,由下式确定薄膜的 光学禁带宽度 *E*_g:

 $(a(h\nu)h\nu)^{2} \propto (h\nu - E_{g}),$ (7) 式中 $a(h\nu)$)为薄膜的的吸光系数.由于 $a(h\nu)$)正比 于吸光度 A,如果用 T 表示薄膜的透射率,则它们 的关系为

$$A = \log \frac{1}{T}.$$

将 $A(h\nu)h\nu$]- $h\nu$ 曲线线性部分延长至横轴即可确 定禁带宽度 E_g .图 4 是 ZnO 浓度为 0.02 mol/L ,ZnO 与 SiO₂ 的摩尔比为 1:5 的复合溶胶制备的 ZnO-SiO₂ 复合薄膜和利用摩尔浓度为 0.02 mol/L 的 ZnO 溶胶 制备的纯 ZnO 薄膜的($A(h\nu)h\nu$)- $h\nu$ 的关系曲线. 对于退火温度为 350 ℃的纯 ZnO 薄膜 ,根据公式计 算对应于两个吸收边 ,禁带宽度也有两个值 ,分别是 E_g = 3.27 eV 和 E_g = 3.76 eV ,其中 3.27 eV 对应于



图 4 ZnO 和 ZnO-SiO2 薄膜的(A(hv)hv) - hv 关系

ZnO 体材料的禁带宽度 ,而 3.76 eV 应该是由量子效 应引起的.用 SiO₂ 包覆的 ZnO 薄膜禁带宽度只有一 个值 , E_g = 3.86 eV.退火温度为 600 ℃的ZnO-SiO₂样 品的 E_g = 3.87 eV.

纳米材料的量子尺寸效应主要表现在随着颗粒 变小 禁带宽度增加 ,光谱结构发生变化和蓝移 .根 据 Brus 模型^{15]} ,禁带宽度 *E*_g 与纳米粒子的粒径 *D* 之间的关系由下式决定:

$$E_{g}^{*} = E_{g}^{\text{bulk}} + \frac{\hbar^{2}\pi^{2}}{2r^{2}} \left(\frac{1}{m_{e}} + \frac{1}{m_{h}}\right) - 1.8 \frac{e^{2}}{4\pi\varepsilon_{e}\varepsilon_{0}r}$$
 (8)

式中 E_s^{bulk}是 ZnO 体材料的禁带宽度, r 是纳米粒子 的半径(D/2), m_e , m_h 分别是电子和空穴的有效质 量 ϵ_0 是真空中的介电常数 , ϵ_1 是相对介电常数 , t_1 是 Plank 常数, e 是电子电量. 取 $E_g^{\text{bulk}} = 3.40 \text{ eV}$, m_e $=0.28m_0$, $m_{\rm h}=0.50m_0^{[16]}$, $\epsilon=8.76^{[17]}$. 图 5 给出 了根据 Brus 模型计算的 ZnO 禁带宽度 E_g和晶粒直 径 D 的关系曲线.由 Brus 公式计算可知,在 320 nm (3.76 eV)左右出现的吸收边是由粒径 D 在 4 nm 左 右的纳米 ZnO 颗粒引起的.当制备 ZnO 的溶胶浓度 很低时,在ZnO薄膜的生长过程中形成了部分ZnO 的量子点 :而另一部分的 ZnO 因团聚长成了较大的 晶粒,所以在没有用 SiO, 包覆的 ZnO 薄膜中既有粒 径小的 ZnO 颗粒,也有粒径大的 ZnO 晶粒.为此,在 可见-紫外光透射光谱中能看到两个明显的吸收边, 一个是在 380 nm 左右体材料的特征吸收边,另一个 是由量子尺寸效应所引起的在 320 nm 左右的吸收 边.随着溶胶浓度的降低,ZnO的团聚减弱,ZnO的 量子点的数量增加,导致薄膜在 320-380 nm 区间 的透射率显著提高.



图 5 ZnO 的禁带宽度 E_g 与粒径 D 的关系

用 SiO₂ 包覆的 ZnO 样品,由于 SiO₂ 的包覆把 ZnO 粒子隔离起来,有效防止了 ZnO 粒子的团聚,没 有形成较大的晶粒.所以,用 SiO₂ 包覆的 ZnO 复合 薄膜没有呈现出相应于体材料的 3.27 eV 那个禁带 宽度,而只出现了一个 3.87 eV 的禁带. 3.87 eV 的 禁带所对应的 ZnO 晶粒的粒径 *D* 在 3.4 nm 左右, 这说明 SiO₂ 包覆使量子效应导致的禁带宽度变得 更宽了.这个实验结果与文献 18,19 报道的结果比 较相符.为了进一步说明玻璃衬底上 ZnO-SiO₂ 中



ZnO 颗粒的尺寸,我们利用 D/max-2500VX 型 X 射线

衍射(XRD) (辐射源为 Cu 靶 Kα 射线, 工作条件

为 40 kV,100 mA)对 ZnO-SiO,复合薄膜进行了 XRD

分析. ZnO-SiO, 样品的 XRD 图谱(图 6)中并没有出

现对应于 ZnO 的衍射峰,这说明 ZnO-SiO,复合薄膜

没有形成较大的 ZnO 晶粒,图 7 是薄膜的扫描电子

图 6 ZnO-SiO, 复合薄膜的 XRD 谱



图 7 ZnO-SiO₂ 复合薄膜的 SEM 照片

6.结 论

利用溶胶凝胶法在玻璃衬底上制备出了 ZnO, ZnO-SiO₂ 纳米复合薄膜.随着溶胶浓度的降低,ZnO 薄膜中存在不同尺寸的 ZnO 颗粒,在可见-紫外光透 射光谱中出现了两个吸收边,分别位于 380 nm(对 应的 *E*₂ 为 3.27 eV)和 320 nm(对应的 *E*₂ 为 3.76

- [1] Hong S S, Joo T H, Pake W, Jun Y H, Yi G C 2003 Appl. Phys. Lett. 83 4157
- [2] Thareja R K, Mitra A 2000 Appl. Phys. B: Lasers Opt. 71 181
- [3] Li Y B , Bando Y , Sato T , Kuras K H 2002 Appl. Phys. Lett. 81 144
- [4] Fu Z P, Yang B F, Li L 2003 J. Phys. Condens. Matter 15 2867
- [5] Mo C M , Li Y H , Zhang Y 1998 J. Appl. Phys. 83 4389
- [6] Chakrabarti S, Ganguli D, Chaudhuri S 2004 Phys. Stat. Sol. A: Appl. Res. 9 2134
- [7] Yamamoto A, Atsuta S, Kanemitsu Y 2005 J. Lumin. 112 169
- [8] Abdullah M , Shibamoto S , Okuyama K 2004 Opt . Mater . 26 95
- [9] Mikrajuddin M, Iskandar F, Okuyama K 2001 J. Appl. Phys. Lett. 89 6431
- [10] Zhao S C , Ji Z G , Yang Y D , Huo D X , Lü Y F 2007 Mater . Lett. 61 2547
- [11] Wang S M Zhao H, Wang A P 2007 Chem. Anal. Meter. 16(24)
 7(in Chinese] 王少明、赵 华、王爱萍 2007 化学分析计量 16

eV)左右.而且随着溶胶浓度的降低,薄膜在 320—380 nm 区间的透射率有所提高.

与纯 ZnO 薄膜相比, ZnO-SiO₂ 纳米复合薄膜中 SiO₂ 的包覆在一定程度上防止了纳米 ZnO 的团聚. ZnO-SiO₂ 复合薄膜只在 310 nm 左右有一个吸收边. SiO₂ 的包覆宽化了 ZnO 的禁带宽度,包覆后的禁带 宽度可达到 3.87 eV,对应的 ZnO 晶粒直径在 3.4 nm 左右.

(24)7]

- [12] Zhang X T, Zhuang J Q, Ren Y L, Xu J J, Wang D J, Bai Y B, Li T J, Yao J N 2000 Acta Phys. Chem. Sin. 16 636(in Chinese)
 [张昕彤、庄家骐、任玉林、徐金杰、王德军、白玉白、李铁津、 姚建年 2000 物理化学学报 16 636]
- [13] Singh P , Kumar A , Kaur D D 2007 J. Cryst. Growth 306 303
- [14] Shan F K , Liu G X , Lee W J , Shin B C 2006 J. Cryst. Growth 291 323
- [15] Brus L E 1984 J. Chem. Phys. 80 4403
- [16] Madelung O, Bomstein L 1988 Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology (Berlin: Springer) p35
- [17] Chen Y, Bagnall D M, Koh H J, Park K T, Hiraga K, Zhu Z, Yao T 2000 J. Appl. Phys. 84 3912
- [18] Burova L I, Petukhov D I, Eliseev A A, Lukashin A V 2006 Superl. Microst. 39 257
- [19] Tan S T , Sun X W , Zhang X H , Chen B J , Chua S J , Yong A , Dong Z L , Hu X 2006 J. Cryst. Growth 290 518

Yuan Ning-Yi He Ze-Jun Zhao Chang-Ning Li Feng Zhou Yi Li Jin-Hua

(School of Mathematics and Physics , Jiangsu Polytechnic University , Changzhou 213164 , China) (Received 16 July 2007 ; revised manuscript received 9 November 2007)

Abstract

ZnO and ZnO-SiO₂ nano-scale thin films were deposited on glass substrates by the sol-gel method. The ultraviole(UV)visible spectrophotometer was used to analyze their optical properties. The UV-visible transmittance spectra of ZnO films showed that when the mole concentration of ZnO precursor decreased from 0.7 to 0.06 mol/L, besides the absorption edge at 380 nm, a new absorption edge around 320 nm appeared. Furthermore the decrease of mole concentration of ZnO precursor improved the transmittance in the range between 380 and 320 nm. However, ZnO-SiO₂ nano-scale thin films only have one absorption edge at 310 nm. The optical band gap of ZnO was enlarged when deposited in SiO₂ matrix.

Keywords : nano-scale ZnO , ZnO-SiO₂ thin films , sol-gel method , transmittance PACC : 7840 , 7360F

⁵⁷ 卷

^{*} Project supported by the Natural Science Foundation of Jiangsu Province , China (Grant No. BK2006042).